NewsRelease NewsRelease NewsRelease

RENESAS

规格表

第8代G8H IGBT系列产品规格表

650V产品

项目		规格
产品编号		RBN40H65T1GPQ-A0 (40A) RBN50H65T1GPQ-A0 (50A) RBN75H65T1GPQ-A0 (75A)
型号名称		RBN40H65T1GPQ-A0#T2 RBN50H65T1GPQ-A0#T2 RBN75H65T1GPQ-A0#T2
集电极到发射极电压 VCES		650 V
栅极到发射极电压VGES		+/- 30 V
集电极电流IC	Tc = 25 °C	80 A, 100A, 150A
	Tc = 100 °C	40 A, 50A, 75A
结温Tj		175 °C
集电极到发射极饱和电压VCE（饱和）		1.5 V
栅极到发射极截止电压VGE（关闭）		5.0 - 6.8 V
封装信息		TO-247

1250 V产品

项目		规格	
产品编号		RBN25H125S1GPQ-A0 (25A) RBN40H125S1GPQ-A0 (40A) RBN75H125S1GP4-A0 (75A)	
型号名称		RBN25H125S1GPQ-A0#T2 RBN40H125S1GPQ-A0#T2 RBN75H125S1GP4-A0#T2	
集电极到发射极电压VCES		1250 V	
栅极到发射极电压 VGES		+/- 30 V	
集电极电流IC	Tc = 25 °C	50 A, 80A, 150A	
	Tc = 100 °C	25 A, 40A	75A
结温Tj		175 °C	
集电极到发射极饱和电压VCE（饱和）		2.1 V	
栅极到发射极截止电压VGE（关闭）		5.0 - 6.8 V	
封装信息		TO-247	TO-247 plus

（备注）所有注册商标或商标均为其各自所有者的财产。